

(2006/01/18)

増設メモリ

増設メモリ

1. 機能仕様

型名	N8102-208	N8102-209	N8102-201
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		

型名	N8102-175	N8102-176
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC	
動作クロック	133MHz	
駆動電圧	2.5V	
バッファ	無	

N8102-176 搭載時はスロット#1 から順に搭載すること。N8102-176 は最大 2 枚まで搭載可。

型名	N8102-186	N8102-187	N8102-188
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	166MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		

型名	N8102-171	N8102-172	N8102-173
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM Registered, ECC		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	有		

型名	N8102-189	N8102-190	N8102-191	N8102-192
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-159	N8102-160	N8102-161	N8102-177	N8102-179	N8102-178
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM,Registered, ECC					
動作クロック	133MHz					
駆動電圧	2.5V					
バッファ	有					

型名	N8102-193	N8102-194	N8102-195	N8102-196
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-125	N8102-126	N8102-127	N8102-180
容量	1GB (256MBx4 枚)	2GB (512MBx4 枚)	4GB (1GBx4 枚)	8GB (2GBx4 枚)
仕様	DDR200(PC1600) SDRAM-DIMM,Registered, ECC			
動作クロック	100MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-167	N8102-168	N8102-169
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	PC133 SDRAM-DIMM, Unbuffered, Low Profile, ECC		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	3.3V		
バッファ	無		

型名	N8102-163	N8102-164	N8102-165
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM, Registered,LowProfile, ECC		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	有		

型名	N8102-197	N8102-198	N8102-199	N8102-200
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	166MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			

型名	N8102-183	N8102-184	N8102-185
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR266 SDRAM-DIMM,Registered,ECC		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	有		

型名	N8102-221	N8102-222	N8102-223
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM,Unbuffered,ECC		
動作クロック	333MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		

型名	N8102-213	N8102-214	N8102-215
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR400(PC3200) SDRAM-DIMM,Unbuffered,ECC		
動作クロック	400MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		

型名	N8102-216	N8102-217	N8102-218
容量	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2 3200) SDRAM-DIMM, Registered,ECC		
動作クロック	400MHz		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	有		

型名	N8102-230	N8102-231	N8102-232	N8102-233
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2 3200) SDRAM-DIMM, Registered, ECC			
動作クロック	400MHz			
駆動電圧	1.8V			
バッファ	有			

型名	N8102-227	N8102-228	N8102-229
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2 4200) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	533MHz		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		

型名	N8102-224	N8102-225	N8102-226
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)	2GB (2GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2 4300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	533MHz		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		

型名	N8102-242	N8102-243
容量	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2 4300) SDRAM-DIMM, Unbuffered	
動作クロック	533MHz	
駆動電圧	1.8V	
バッファ	無	

型名	N8102-G227	N8102-G228	N8102-G229
容量	256MB (256MBx1 枚)	512MB (512MBx1 枚)	1GB (1GBx1 枚)
仕様	DDR2 533(PC2 4300) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	533MHz		
駆動電圧	1.8V		
バッファ	無		
補足	組込出荷専用メモリボード		

型名	N8102-G221	N8102-G222	N8102-G223
容量	512MB (256MBx2 枚)	1GB (512MBx2 枚)	2GB (1GBx2 枚)
仕様	DDR333(PC2700) SDRAM-DIMM, Unbuffered, ECC		
動作クロック	333MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		
補足	組込出荷専用増設メモリボード		

型名	N8102-235	N8102-236
容量	2GB (1GBx2 枚)	4GB (2GBx2 枚)
仕様	DDR2 400(PC2 3200) SDRAM-DIMM,Registered, ECC	
動作クロック	400MHz	
駆動電圧	1.8V	
バッファ	有	

2. 用語集

■SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)

従来のDRAMと比べて内部は基本的に同じであるが、外部バスインターフェイスが一定周期のクロック信号に同期して動作するように改良されたDRAM。

Pentium,Pentium II, Pentium III, Pentium III Xeon,Pentium 4,XeonなどのCPUも、その外部バスはクロックに同期して動くため、CPUとSDRAMのクロックを共通にすればアクセス時のロスを少なくできる。

SDRAMで高速化できるのは、1クロック毎にデータを転送するバーストモードである。従来のDRAMを利用する場合、Pentium,Pentium II ,Pentium III, Pentium III Xeon,Pentium 4,Xeonではバーストモード時にウェイトを挿入しなければならない事が多いが、シンクロナスDRAMを用いればノーウェイトでCPUのバーストモードに追従できる。ただし、バーストモードの最初のアクセスは速くならない。

■DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

SDRAMを改良して、外部クロックの2倍の周期でデータをやり取りできるようにしたSDRAM。

SDRAMがクロックの立ち上がりのみを利用するのに対し、立ち上がりと立ち下がり両方を利用し、同じクロックで2倍のデータ転送を実現する。

3. 注意事項

- ・ Express5800 シリーズ用に販売されている他社製メモリは動作保証の範囲外となるため、Express5800 純正品のメモリを使用すること。